

	<h2 style="color: #D9534F;">SI6562DQ-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI6562DQ-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 8-TSSOP
	Datenblätter:  SI6562DQ-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 18974 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI6562DQ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18974 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 4.5A, 4.5V
Leistung - max	1W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Andere Namen	SI6562DQ-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 4.5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 20V 1W Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Basisteilenummer	SI6562

SI6562DQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6562DQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6562DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6562DQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6562DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 8-TSSOP</p>	 <p>SI6562DQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 8-TSSOP</p>	 <p>SI6562DQ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 8-TSSOP</p>	 <p>SI6801DQ-T1-E3 VISHAY SI6801DQ-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI6633MR SANKEN SANKEN QFN36</p>	 <p>SI6802DQ SILICONIX SI6802DQ SILICONIX</p>	 <p>SI6801DQ SI SI6801DQ SI</p>	 <p>SI6801DQ-T1 SILICON SI6801DQ-T1 SILICON</p>

SI6562DQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI6562DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6562DQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6562DQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6562DQ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI6562DQ-T1-GE3
SI6562DQ-T1-GE3 Electronic	SI6562DQ-T1-GE3-Komponenten	SI6562DQ-T1-GE3-Verteiler	SI6562DQ-T1-GE3-Bild	SI6562DQ-T1-GE3-Teil
SI6562DQ-T1-GE3 Preis	SI6562DQ-T1-GE3 Hersteller	SI6562DQ-T1-GE3 Bild	SI6562DQ-T1-GE3 Aktie	SI6562DQ-T1-GE3 Inventar
SI6562DQ-T1-GE3 Neu	SI6562DQ-T1-GE3 Original	SI6562DQ-T1-GE3 garantiert	SI6562DQ-T1-GE3 RFQ	SI6562DQ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited